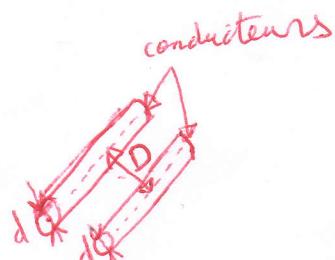


## II. 1. Les lignes filaires:

ce chapitre détaille la détermination de les paramètres pour les lignes filaires (câble coaxiale et ligne Bifilaire) et la ligne microondes.

### II. 1. 1. Ligne Bifilaire

Les lignes Bifilaires sont de moins utilisées. On s'en servait principalement raccorder une antenne à une télévision.



Soient  $d$  le diamètre des conducteurs de la ligne et  $D$  leur espacement d'axe à axe.

figure II. 1. ligne Bifilaire

#### II. 1. 1. Paramètres primaires

les valeurs par unité de longueur de la résistance, de l'inductance, de la conductance et de la capacité sont respectivement :

$$\bullet R_1 = \sqrt{\frac{4 \rho f}{\pi}} \cdot \frac{1}{d \sqrt{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2}} = 1,26 \cdot 10^{-3} \sqrt{\frac{f}{s}} \cdot \frac{1}{d \sqrt{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2}} \quad (\Omega/m)$$

$$\bullet L_1 = \frac{\mu_0}{\pi} \ln\left(\frac{2D}{d}\right) = 0,40 \cdot 10^{-6} \ln\left(\frac{2D}{d}\right) \quad (H/m)$$

$$\bullet G_1 = \frac{\epsilon_0}{\pi} \frac{4 \pi f \operatorname{tg} s}{\ln\left(\frac{2D}{d}\right)} = 0,171 \cdot 10^{-9} \frac{4 \pi f \operatorname{tg} s}{\ln\left(\frac{2D}{d}\right)} \quad (S/m)$$

$$\bullet C_1 = \frac{\pi \epsilon_r}{\ln\left(\frac{2D}{d}\right)} = 0,028 \cdot 10^{-9} \frac{\epsilon_r}{\ln\left(\frac{2D}{d}\right)} \quad (F/m)$$

$\epsilon$ : conductivité des conducteurs.

$\epsilon_r$ : constante diélectrique relative

$\operatorname{tg} s$ : facteur de pertes du diélectrique.

#### II. 1. 1. 2. Paramètres secondaires.

a) L'affaiblissement :

l'affaiblissement de la ligne Bifilaire est donné par la formule

$$\textcircled{1} \quad \alpha_{(N_p)_m} = \sqrt{\frac{\pi \epsilon_f}{\sigma}} \cdot \frac{\left[1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}{d \ln\left(\frac{2D}{d}\right)} + \frac{\pi f \operatorname{tg} s}{\sigma}$$

le premier terme représente les pertes  $\alpha_c$  dans les conducteurs et que le second représente les pertes  $\alpha_d$  dans diélectrique.

$$\bullet \alpha_c (\text{dB/m}) = 4\pi \cdot 10^6 \sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_r}} \left| \frac{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2}{d \ln \frac{2D}{d}} \right|^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha_d (\text{dB/m}) = 9.1 \cdot 10^3 \sqrt{\epsilon_r} f \text{ tgs}$$

### b) le paramètre de phase.

le paramètre de phase d'une ligne Bifilaire est donné par la relation suivante :  $B = \omega \sqrt{L_1 C_1} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r}$

$$\text{comme } B = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi f \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{c} = \frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{\lambda_0},$$

$$\text{donc : } \lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

### c) Vitesse de phase :

$$V_p = \frac{\omega}{B} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

### d) Impédance caractéristique :

L'impédance caractéristique de la ligne Bifilaire est donnée par la relation suivante (ligne avec perte).

$$\begin{aligned} Z_C &= \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\pi} \cdot \frac{1}{\pi \epsilon} \ln \frac{2D}{d}} = \frac{120}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{2D}{d} \\ &= \frac{276}{\sqrt{\epsilon_r}} \log \frac{2D}{d} \quad (-2) \end{aligned}$$

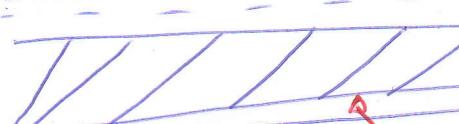
## II. 2. ligne coaxiale :

### II. 2. 1. les paramètres Primaires

gaïne protectrice



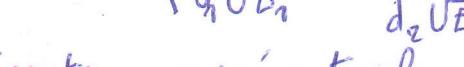
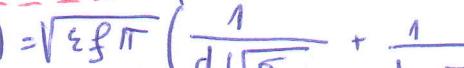
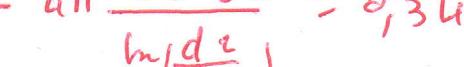
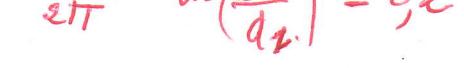
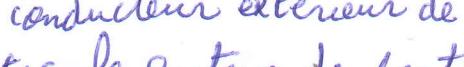
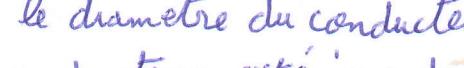
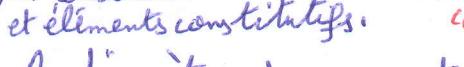
conducteur intérieur



figuré 11 ligne coaxiale : géométrie et éléments constitutifs.

conducteur extérieur

isolant de constante diélectrique  $\epsilon_r$



### • Paramètre de phase

le paramètre de phase d'une ligne avec perte est donné par la relation suivante:

$$\beta = \omega \sqrt{L_1 C_1}$$

$$\beta = 2\pi \frac{c}{\lambda_0} \sqrt{\epsilon_r \mu_0} = 2\pi \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{\lambda_0}.$$

comme par définition,  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ , il en résulte que la longueur d'onde sur la ligne ( $\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$ )

### • Vitesse de phase

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

### • Impédance caractéristique

L'impédance caractéristique est donnée par la formule suivante

$$Z_c = \sqrt{L_1 / C_1} \quad (\text{lignes avec perte})$$

$$\text{donc: } Z_c = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left( \frac{d_2}{d_1} \right) = \frac{138}{\sqrt{\epsilon_r}} \log \frac{d_2}{d_1} \quad (n)$$

## II. 3. les lignes à bandes et à fentes

Il y a une grande variété de lignes à structure bidimensionnelle, appelées parfois lignes planaires, qui ont fait l'objet d'application pour la réalisation des circuits passifs et des circuits actifs hyperfréquences. On peut les classifier en deux catégories : les lignes à bande et les lignes à fente.

### ~~II. 3.1~~

#### ① La ligne microbande (en anglais microstrip).

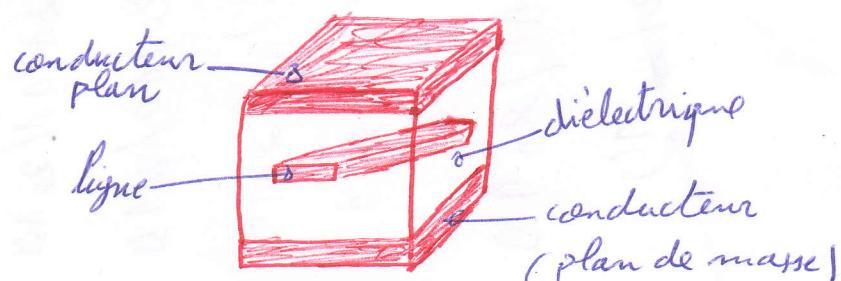
Elle comporte un substrat en diélectrique, complètement métallisé sur l'une de ses faces et couvert d'une bande métallique sur l'autre



plan de masse métallique.

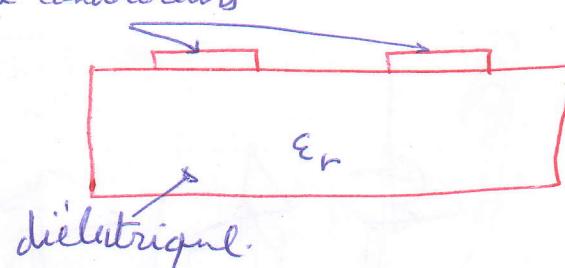
#### ② La ligne triplaque (stripline).

Elle est constituée par deux plaques métalliques séparées par un substrat de diélectrique au sein duquel se trouve une bande métallique.



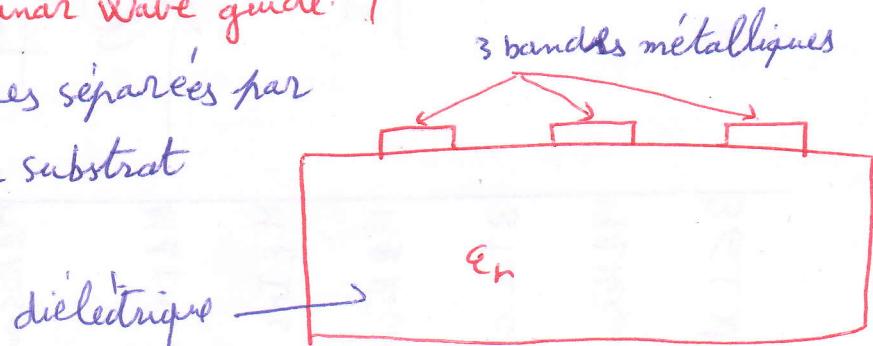
#### ③ La ligne à fente (slot line)

Les <sup>deux</sup> conducteurs formant la ligne sont déposés sur la même face du substrat diélectrique



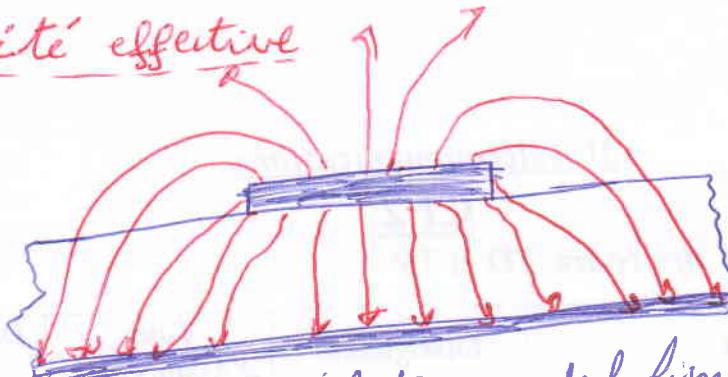
#### ④ Le guide coplanaire (coplanar wave guide)

Il présente 3 bandes métalliques séparées par deux fentes d'une même côté du substrat

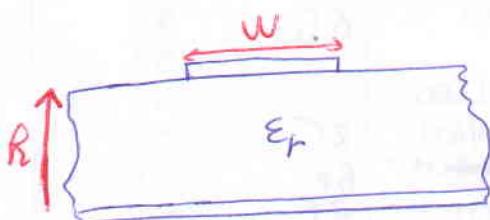


## II.3.4: caractéristique des ligne micro-Bande (ligne à Bande).

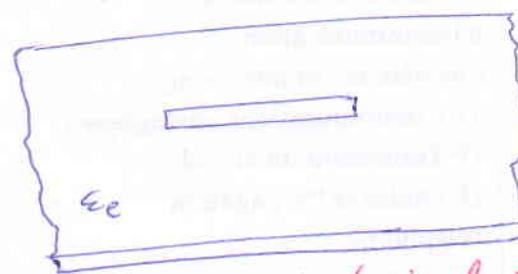
### A Permittivité effective



lignes de champ électrique de la ligne microbande



Microbande réelle



Microbande équivalente.

✓ Une formule explicite explicitée de  $\epsilon_e$  a été donnée par Hammerstad.

• Pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} \geq 1$ :

$$\epsilon_e = \frac{1}{2} (\epsilon_r + 1) + \frac{1}{2} (\epsilon_r - 1) \left(1 + 12 \frac{R}{W}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

• pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} \leq 1$ :

$$\epsilon_e = \frac{1}{2} (\epsilon_r + 1 + \frac{1}{2} (\epsilon_r - 1) \left[ \left(1 + 12 \frac{R}{W}\right)^{-\frac{1}{2}} + 0,04 \left(1 - \frac{W}{R}\right)^2 \right]$$

✓ Notons que, de cette permittivité effective, l'on déduit:

• la longueur d'onde  $\lambda_m$  sur la ligne microbande, d'après :

$$\lambda_m = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_e}} \quad \text{avec: } \lambda_0 = \frac{c}{f}$$

• le paramètre de phase  $\beta$ , d'après:  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_m} = \frac{2\pi c}{\lambda_0 \sqrt{\epsilon_e}}$

• la vitesse de propagation, d'après:  $V_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_e}} = \frac{w}{B} = \frac{2\pi c}{\lambda_0 \cdot \frac{2\pi}{\lambda_m}}$

$$= \frac{c}{\lambda_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_e}} = \frac{c}{\lambda_0}$$

## B Impédance caractéristique. (Analyse microbande)

Formule de Wheeler et Hammerstad

pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} > 2$

$$Z_c = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \left[ \frac{w}{h} + 1,393 + 0,667 \ln \left( \frac{w}{h} + 1,444 \right) \right]^{-1} \quad (2)$$

pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} < 2$

$$Z_c = \frac{Z_0}{2\pi\sqrt{\epsilon_{eff}}} \ln \left( \frac{8h}{w} + \frac{w}{4R} \right) \quad (2)$$

Ces relations permettent d'effectuer l'analyse d'une ligne microbande, c'est-à-dire de déterminer  $\epsilon_{eff}$  et  $Z_c$  en fonction de la ligne et de la permittivité du substrat.

Formule de Hammerstad Wheeler

pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} > 2$

$$Z_c = \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \cdot \left[ \frac{w}{h} + 0,883 + \frac{\epsilon_r - 1}{\pi \epsilon_r} \left( \ln \left( \frac{w}{2h} + 0,94 \right) + 1,473 \right) + 0,165 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r^2} \right]^{-1}$$

pour les bandes telles que  $\frac{W}{R} < 2$

$$Z_c = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{\epsilon_r + 1}} \left[ \ln \left( \frac{8h}{w} \right) + \frac{1}{8} \left( \frac{w}{2h} \right)^2 - \frac{\epsilon_r - 1}{2(\epsilon_r + 1)} \left( \ln \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\epsilon_r} \ln \frac{4}{\pi} \right) \right]$$

## C Synthèse microbande :

Pour effectuer l'opération inverse d'analyse, c'est-à-dire trouver le quotient  $\frac{W}{R}$  donnant une impédance caractéristique  $Z_c$  demandée,

on dispose également de relations approchées

$$\text{Si } \frac{W}{R} \leq 2 : \frac{W}{R} = \frac{8\epsilon^A}{\epsilon^A - 2} = \frac{4[\epsilon^A - \epsilon^{-A}]}{\epsilon^A + \epsilon^{-A}}$$

$$\text{Si } \frac{W}{R} \geq 2 : \frac{W}{R} = \frac{\epsilon_r - 1}{\pi\epsilon_r} \left( \ln(B - \epsilon) + 0,39 - \frac{0,61}{\epsilon_r} \right) + \frac{2}{\pi} (B - \epsilon - \ln(2B - \epsilon))$$

$$A = \pi \sqrt{2(\epsilon_r + 1)} \cdot \frac{Z_c}{Z_0} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left( 0,23 + \frac{0,11}{\epsilon_r} \right)$$

$$B = \frac{\pi}{2\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{Z_0}{Z_c}$$

$$(Z_0 = 120\Omega)$$

(2)

## D : Affaiblissement d'une ligne microbande

pertes dans le conducteur

- En pratique la limite supérieure des pertes dans le conducteur sont calculées par la formule approchée suivante :

$$\alpha_c (\text{dB/m}) = 8,686 \frac{R_s}{W \cdot f}$$

$R_s = \sqrt{\pi M P f}$  où  $\rho$  est la résistivité du conducteur.  
 $f$  : la fréquence.

$Z_c$  : impédance caractéristique de la microbande.

- pertes dans le diélectrique ; les pertes diélectriques dépendent principalement des caractéristiques du substrat telles que l'angle de perte ( $\tan \delta$ ) et la permittivité relative ( $\epsilon_r$ ) .

$$\alpha_d (\text{dB/m}) = 4,34 \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \cdot \frac{\epsilon_{eff} - 1}{\epsilon_r - 1} \sigma_d$$

$$\text{ou } \sigma_d = 27,3 \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} \cdot \frac{\epsilon_{eff} - 1}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \cdot \frac{\tan \delta}{\lambda_0}$$

$\sigma_d = w \epsilon_r \epsilon_r \tan \delta$  est la conductivité du diélectrique.

- pertes par rayonnement

D'après Hammerstad ces pertes sont proportionnelles à  $(R_f)^2 / \sqrt{\epsilon_r}$  pour une ligne  $Z_c = 50 \Omega$ .

la fréquence limite est donnée par l'équation suivante.

$$f_M (\text{GHz}) = 2,14 \frac{(\epsilon_r)^{1/4}}{h(\text{mm})}$$

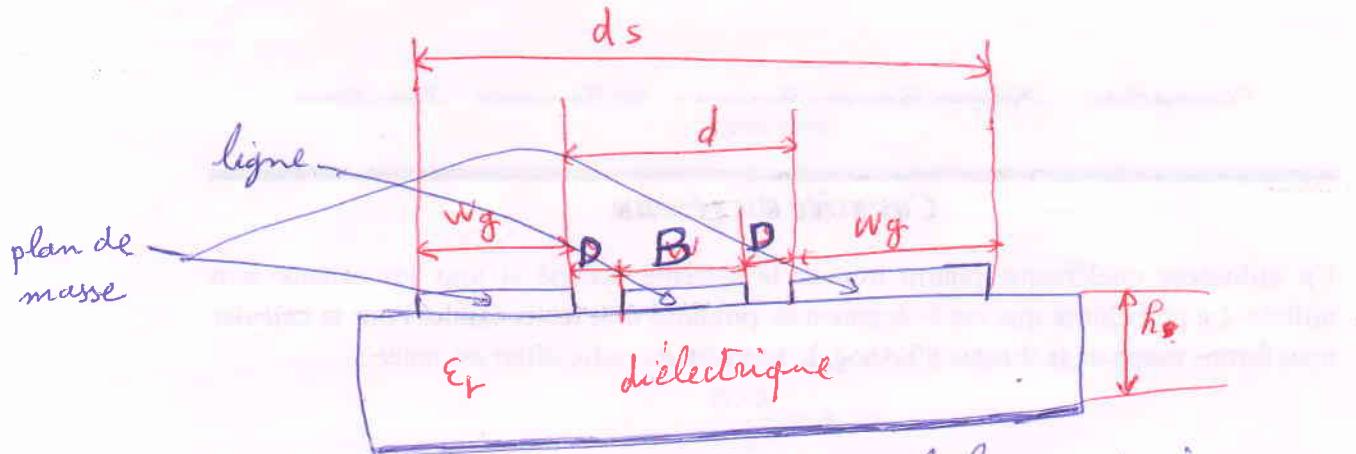
Par exemple, pour un substrat de  $h=1 \text{ mm}$ ,  $\epsilon_r=2,1$   $\Rightarrow f_M = 3 \text{ GHz}$ .  
 et  $h=1 \text{ mm}$ ,  $\epsilon_r=10 \Rightarrow f_M = 11 \text{ GHz}$ .

Affaiblissement d'une ligne microbande



- pertes dans les conducteurs
- pertes dans le diélectrique
- pertes de rayonnement (fréquence limite)

## II.3.2 caractéristique de ligne coplanaire (ligne à fente)



paramètre géométrique de la ligne coplanaire

- La ligne coplanaire est constituée par un ruban de largeur  $B$ , séparé du plan de masse par deux fentes de largeur  $D$ . Elle n'occupe qu'un seul côté du substrat, c'est une ligne inhomogène, mais comme la ligne miro-ruban, elle supporte un mode quasi-TEM.

- L'impédance caractéristique équivalente de la ligne coplanaire s'écrit grâce à modèle de Wen.

$$Z_C = \frac{30\pi}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \cdot \frac{K(k)}{K(k)} \quad \text{avec } k = \frac{B}{B+2 \cdot D}$$

$$\text{et: } \epsilon_{eff} = 1 + \left( \frac{\epsilon_r - 1}{2} \right) \left| \left( \frac{K(k_e) \cdot K(k_{e1})}{K(k) \cdot K'(k_e)} \right) \right| \quad \text{avec } k_1 = \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{\pi \cdot B}{4k}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{\pi(B+2 \cdot D)}{2k}\right)}$$

la fonction  $K(k)$  représente l'intégrale elliptique complète de premier espèce :  $K'(k) = K(k')$       avec       $k' = \sqrt{1 - k^2}$

- L'approximation du rapport  $\frac{K(k)}{K'(k)}$ ,

pour:  $0 \leq k \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\frac{K(k)}{K'(k)} = \frac{\pi}{\ln\left(\frac{2\sqrt{1+Uk^2}}{1-Uk^2}\right)}$$

$\frac{1}{\sqrt{2}} < k \leq 1$

$$\frac{K(k)}{K'(k)} = \frac{1}{\pi} \ln\left(\frac{2\sqrt{1+Uk^2}}{1-Uk^2}\right)$$